

(問題8の続き)

- (1) 真空中に蓄えられる電場のエネルギーは $U = \frac{1}{2} \int_V \epsilon_0 |E|^2 dV$ で与えられる。電場が静電場のとき

$$U = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV$$

となることを示せ。ただし V は電場が拡がる体積領域, ρ は電荷密度, ϵ_0 は真空中の誘電率であり, 電束密度 D と電場 E の間には $D = \epsilon_0 E$ の関係があるものとする。

- (2) 表面電荷が, $+Q, -Q$, 表面の静電ポテンシャルが ϕ_1, ϕ_2 であるような任意の形をした孤立した導体を考える。この二つの導体が作る静電エネルギーを求めよ。
- (3) 電気容量 C_1, C_2, \dots, C_N を各々持つ N 個のコンデンサーが導線によって接続されている閉回路を考える。 N 個のコンデンサーが直列に接続されている場合と, 並列に接続されている場合の合成容量を, それぞれ導出せよ。

問3 次の文を読み, 設問(1)~(3)に答えよ。

電流 I が流れる導線上にコイル素子を連結した回路を考える。このコイルを貫く磁束が, $\Psi = LI$ で与えられるとき, L をこの回路素子における自己インダクタンスという。このとき誘導起電力 ε は $\varepsilon = -L \frac{d}{dt} I$ で与えられる。

- (1) 自己インダクタンス L をもつ一個のコイルに電源をつないで電流を流すことを考えよう。電源の起電力を V , コイルの抵抗を R としたとき, 電流 I と V の満たす関係式を求めよ。
- (2) さらに電気容量 C のコンデンサーを直列に接続する。コンデンサーに蓄えられている電荷を Q とした場合の I と V の関係を求めよ。
- (3) 設問(2)の状況において時間変化する電流 I が流れているときに電源が単位時間あたりにする仕事 W を求め, 各項の物理的意味を説明せよ。ただし, 必要に応じて, 回路を流れる電流 I とコンデンサーに蓄えられる電荷 Q の間には $I = dQ/dt$ が成り立つことを用いてよい。